

シリコン系光導波路と フォトニクスデバイス集積技術の開発

1名分料金で
2人目無料セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/240543>

- ◆日時:2024年05月21日(火) 13:00~16:30
- ◆【アーカイブ配信受講:5/22(水)~5/29(水)】の視聴を希望される方は、
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/240543> こちらからお申し込み下さい
- ◆【WEB限定セミナー】在宅、会社にながらセミナーを受けられます
- ◆受講料:1名につき49,500円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
・1名で申込の場合、**46,200円(税込)**へ割引になります。
・2名同時申込で両名とも会員登録していただいた場合、**計49,500円(2人目無料)**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師:国立研究開発法人 産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター 主任研究員 博士(工学)高 磊 氏

【講演の趣旨】

シリコンフォトニクス技術と呼ばれる、シリコン系光導波路素子によるモノリシック/ハイブリッド集積や実装技術は、基礎的な研究フェーズから、産業展開へと続く実用化フェーズへ移行しており、市場規模は著しい成長を続けている。しかしながら、更に高密度・高性能な光集積回路の実現に向けて、解決すべき技術課題は依然として多く存在するため、新たなブレークスルーが求められる。

本セミナーでは過去20年間に渡る技術動向調査を基にした、基礎的な素子動作原理から最先端技術について解説を行った上で、現在の諸課題について議論を行う。

【プログラム】

1. 光導波構造の基礎
 - 1.1 1次元の光閉込めと光伝搬
 - 1.2 2次元(3層スラブ導波路)の固有値方程式と導波モード形成
 - 1.3 高次モードとカットオフ
 - 1.4 ガラス, 化合物半導体, シリコン系導波路の比較
2. シリコン系光導波路デバイス
 - 2.1 パッシブ光デバイス(カプラ, フィルタ, 入出力光結合など)
 - 2.2 光変調器
 - 2.3 受光器
 - 2.4 レーザー光源
3. フォトニクス集積技術
 - 3.1 ムーアの法則と集積フォトニクスデバイスの活用
 - 3.2 CMOS互換モノリシック集積技術
 - 3.3 多彩な異種材料を活用したハイブリッド集積技術
 - 3.4 光チップレット, 2.5/3次元実装
 - 3.5 ファブレス化, ファウンドリーサービスの現状

『シリコンフォトニクス』セミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒< LIVE / アーカイブ >

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>